

## Fiche d'application n° 11

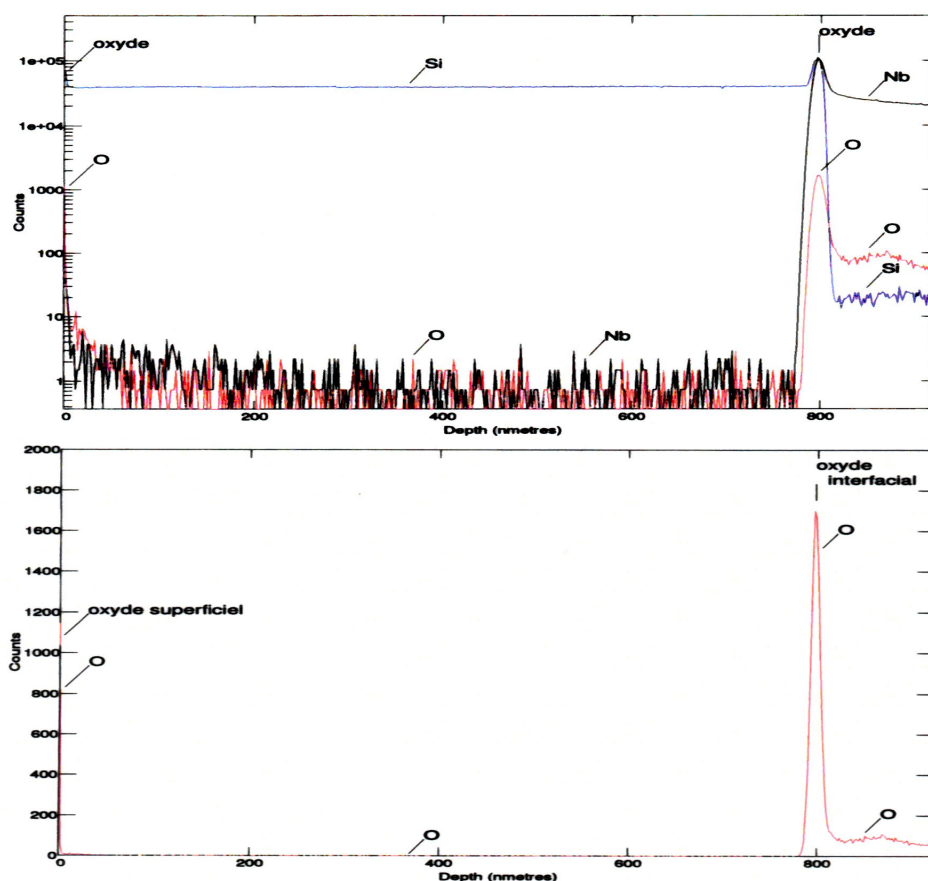
### Caractérisation d'une structure Si/Nb après recuit thermique

**Objet :** Contrôle de la diffusion du niobium dans la couche de silicium et de l'éventuelle présence d'un oxyde à l'interface

### Technique mise en œuvre : SIMS

- ✓ Profils de répartition en profondeur avec une excellente résolution en profondeur
- ✓ Très grande sensibilité

### Résultats



### Conclusion :

- ✓ Présence d'une couche d'oxyde interfaciale
- ✓ Pas de diffusion de Nb dans Si